



# 2025年12月期第3四半期決算説明

2025年11月11日

代表取締役社長 川上 潤  
取締役副社長 尾形 潔

本資料は、リガク・ホールディングス株式会社（以下「当社」といいます）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、米国、日本国またはそれ以外の一切の法域における当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。米国、日本国またはそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づき登録若しくは届出またはこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集または販売を行うことはできません。

本資料には、当社または当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「予定」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報をもとに、本資料の作成時点における当社の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提・仮定の下になされています。そのため、これらの記述または前提・仮定は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。このリスクや不確定要素には、例えばX線分析機器の需要の悪化、当社のブランド、製品およびサービスに関するレピュテーション、市場における競争状況、海外事業展開に伴うリスク、物価変動、為替変動、労働コストの変動、規制動向、事業成長戦略の遂行可能性、個人情報・機密情報の保護、裁判手続等の動向、大規模災害の発生その他の要因が含まれます。

当社の現在の決算期は12月末であります。また、当社は、2022年1月1日を移行日として、2023年12月期より国際財務報告基準（以下「IFRS」といいます）を採用しております。

本資料には、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後営業利益、調整後営業利益率、研究開発費比率、設備投資額比率、調整後当期利益、フリーキャッシュ・フローなど、当社のNon-IFRS指標に関する記述がありますが、これらはIFRS、日本基準その他の会計基準に基づく財務数値に代替するものではありません。かかるNon-IFRS指標の当社における使用、定義および算定は、他社における同様の名称の財務指標とは大きく異なる可能性があり、直接的に比較することはできません。これらの財務数値の算出根拠等の詳細についてはAppendixをご参照ください。また、本資料には、製品区分別売上収益および営業利益並びにエンドマーケット別売上収益等の管理会計ベースの財務情報が含まれています。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもありません。

なお、本資料における記述は本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。そのため、本資料に記載されている将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報または第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

## 【アジェンダ】

1. 2025年12月期第3四半期連結決算概要と2025年通期業績  
予想達成に向けた進捗
2. 成長戦略アップデートと2026年度の方向性

# 1. 2025年12月期第3四半期連結決算概要と2025年通期業績 予想達成に向けた進捗

---

全社

- 売上は想定範囲内に着地し、3Q累計で前年同期比(YoY)▲4.9%
- 調整後EBITDA/当期利益は、全体的な減収、半導体プロセス・コントロール機器における高GM<sup>(1)</sup>案件の4Qへの集中、戦略投資の継続等によりYoYで大幅減少。業績は3Q大底で4Q回復へ

多目的  
分析機器

- 市場サイクル等の要因で3Q累計売上はYoY▲5.3%となるが、3Q(7月-9月)はYoY+19.4%と反転
- 海外売上は、中国を除き累計売上YoY+11%と引き続き順調

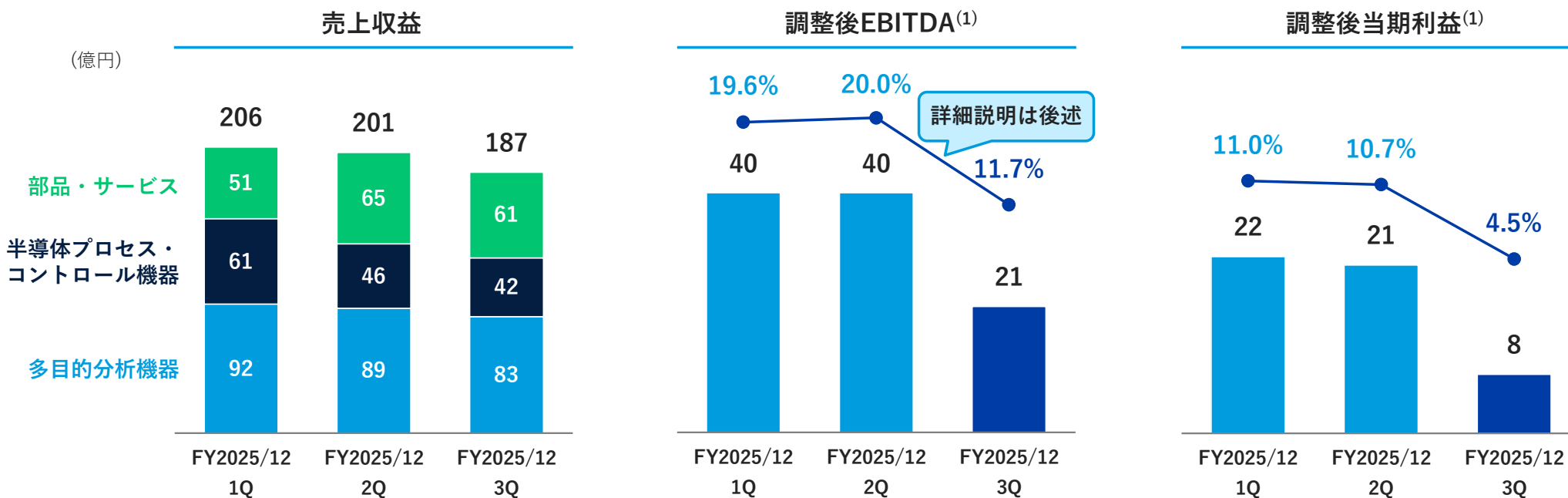
半導体  
プロセス・  
コントロール  
機器

- 量産から研究開発需要へのシフトによる4Qへの売上集中により、3Q累計売上でYoY▲5.6%
- 顧客Mix変化等による営業利益率低下は一時的。4Qはボリューム拡大・Mix改善で営業増益を確保へ
- 4Q売上予想のうち最終条件交渉フェーズ案件は約5%まで縮小、業績予想達成の確度は一層高まる

3Qで底打ち。4Qでは大幅売上増と高GM案件の実現により、通期業績予想達成に向けて進捗

注：  
1. Gross Margin

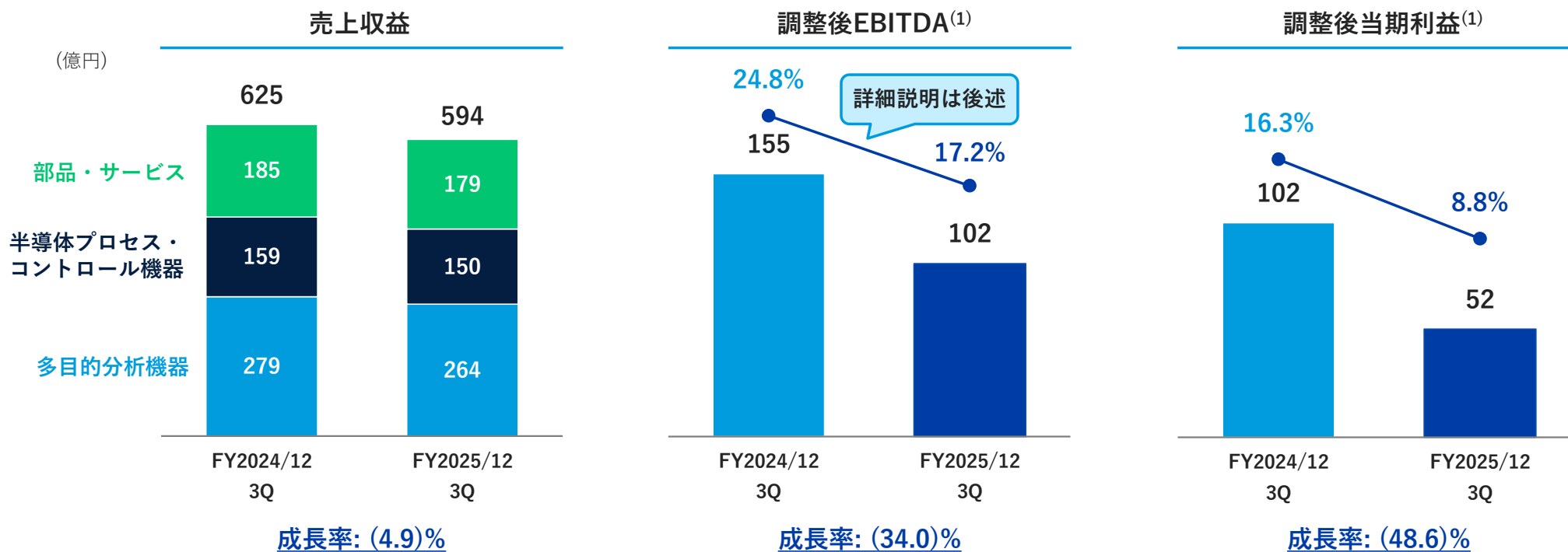
- 3Q売上高は、半導体プロセス・コントロール機器市場の量産投資遅れ、EUV向け多層膜ミラーの需要減等の影響によりQoQで減少したが、想定範囲内で着地
- 調整後EBITDA/当期利益のQoQ減少は、売上減に加え、製品・地域Mixの影響、及び成長投資継続による



注:

1. Non IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage30、31に詳細を記載

- 3Q累計売上高はYoY▲4.9%で想定範囲内に着地
- 調整後EBITDA/当期利益のYoY減少は、売上減に加え、半導体プロセス・コントロール機器における高GM%案件の4Q集中、EUV向け多層膜ミラーの需要減、R&D等の戦略投資などが影響



注：  
1. Non IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage30、31に詳細を記載

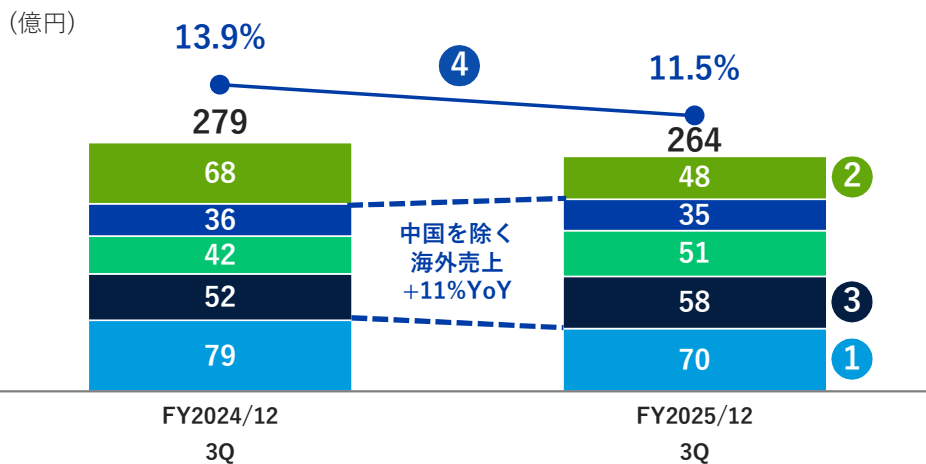
	EBITDAマージン変動率		変動要因	4Q/見込み
	QoQ▲8.3pts	累計YoY▲7.6pts		4Q大幅改善。 年間ではガイダンス並みで着地
粗利率	▲3pts	▲3pts	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A</b> 日本：XRFの個別低マージン案件は想定線</li> <li><b>B</b> 年間累計で価格規律によるGM%改善</li> <li><b>C</b> 高マージン市場の米州での3Q装置ゼロ売上</li> <li><b>D</b> アジアでの個別低マージン案件(複数)</li> <li><b>E</b> 前年3Q累計での高マージン案件集中</li> <li><b>F</b> EUV向け多層膜ミラー売上減</li> </ul>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">多目的分析機器</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4Q高マージン案件貢献</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>多目的 ▲2pts <b>A</b></li> <li>半導体 ▲2pts <b>C D</b></li> <li>部品・サ +1pts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>多目的 +1pts <b>B</b></li> <li>半導体 ▲3pts <b>C D E</b></li> <li>部品・サ ▲1pts <b>F</b></li> </ul>	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">半導体プロセス・ コントロール機器</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4Q半導体での高マージン案件集中</li> <li>■ 個別低マージン案件無し</li> </ul>	
売上減に伴うSG&A比率増	▲3pts <b>G</b>	▲2pts <b>G</b>	<b>G</b> 多目的市場サイクル&半導体開発案件シフト	■ 売上回復に伴いマイナス解消方向へ
SG&A費増	▲2pts <b>H</b>	▲2pts <b>H</b>	<b>H</b> 戦略投資(R&D、採用他)継続	■ 利益見ながらコントロール

▶▶▶ 3Qは半導体の売上地域Mix、個別低GM案件、全体的な減収の影響でEBITDA率が一時的に低下  
ただし、それらの要因は4Qでは解消し全体の利益率は大きく改善する見込み(4Q見通しは後述)

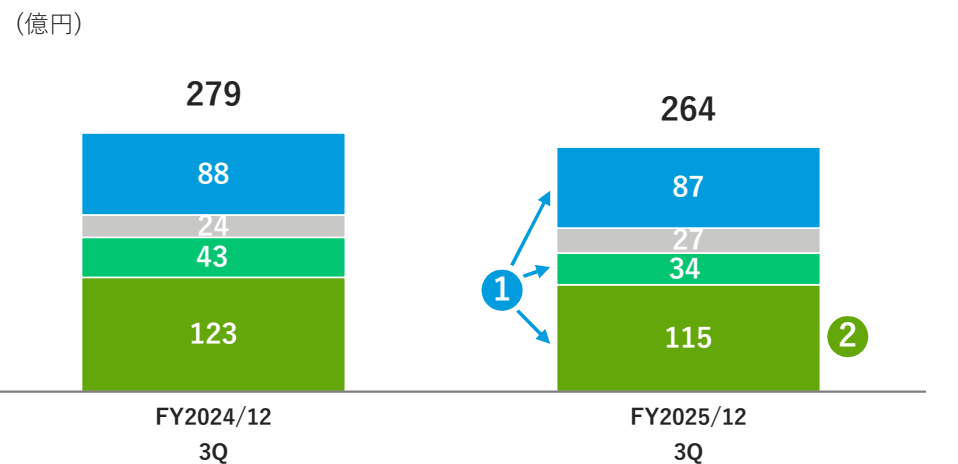


- 3Q累計売上高は前年度の中国補正予算案件と日本の大型案件集中の反動によりYoY▲5.3%。ただし、3Q(7-9月)ではYoY+19.4%で回復基調
- 中国を除く3Q累計海外売上はYoY+11%で順調に推移。シェア拡大も継続

地域別売上収益



エンドマーケット別売上収益



■ 日本 ■ 米州 ■ 欧州 ■ アジア(中国以外) ■ 中国 ● 営業利益率

■ アカデミア/ガバメント ■ 半導体・電子部品 ■ ライフサイエンス ■ その他産業

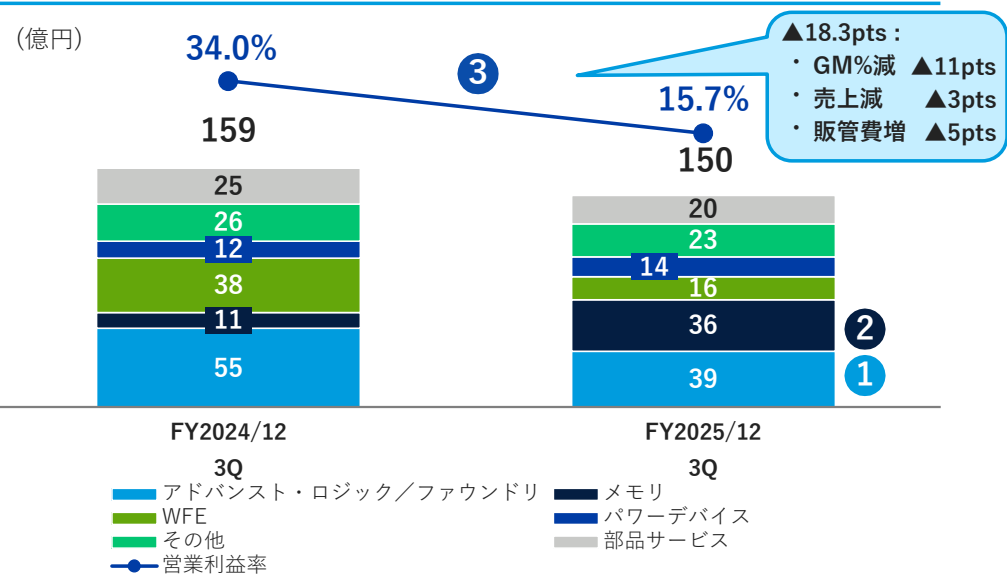
- ① 日本：想定通りに推移し、3Q(7月-9月)ではYoY +30%の伸長
- ② 中国：想定通りに推移し、3Q(7月-9月)ではYoY +10%の伸長
- ③ 米州：年初の高い受注残によりYoY +10%増。米関税に対しては価格転嫁に成功、アカデミア予算削減の影響は4Q以降発現の見込み
- ④ GPマージン<sup>(1)</sup>率は価格コントロール、製品Mixにより向上(+1pt)。但し、売上の減少により営業利益率は低下

注：

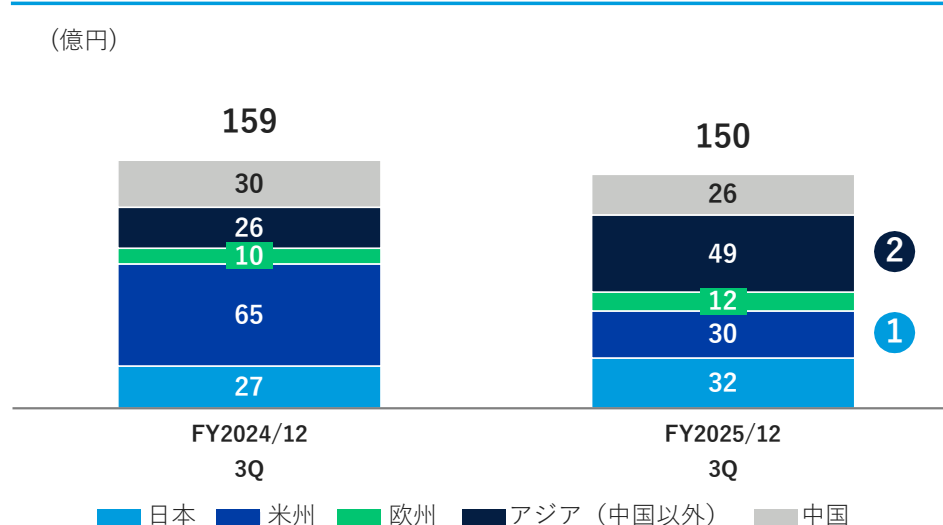
1. 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での納入等フィールドサービス関連費用を売上原価に計上する方法へ変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用

- 3Q累計売上高は、量産から研究開発需要へのシフトに伴う4Qへの売上集中によりYoY▲5.6%
- アジア、日本の案件により3Q(7月-9月)の売上は想定を若干上回る。マージン率はMixに加えて、個別案件により一時的に低下。4Qでのリカバリーと売上予想(125億円)の実現に向け着実に進捗

アプリケーション別売上収益

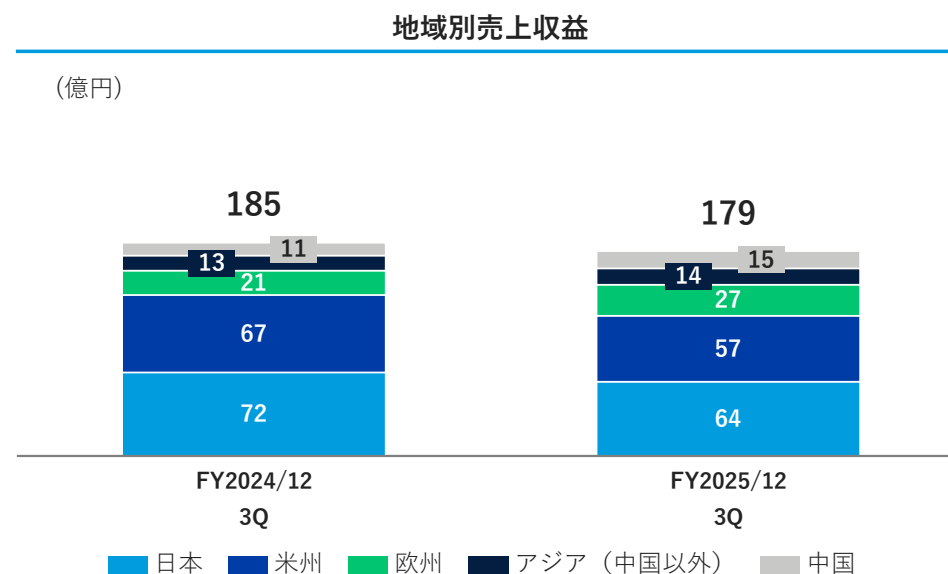
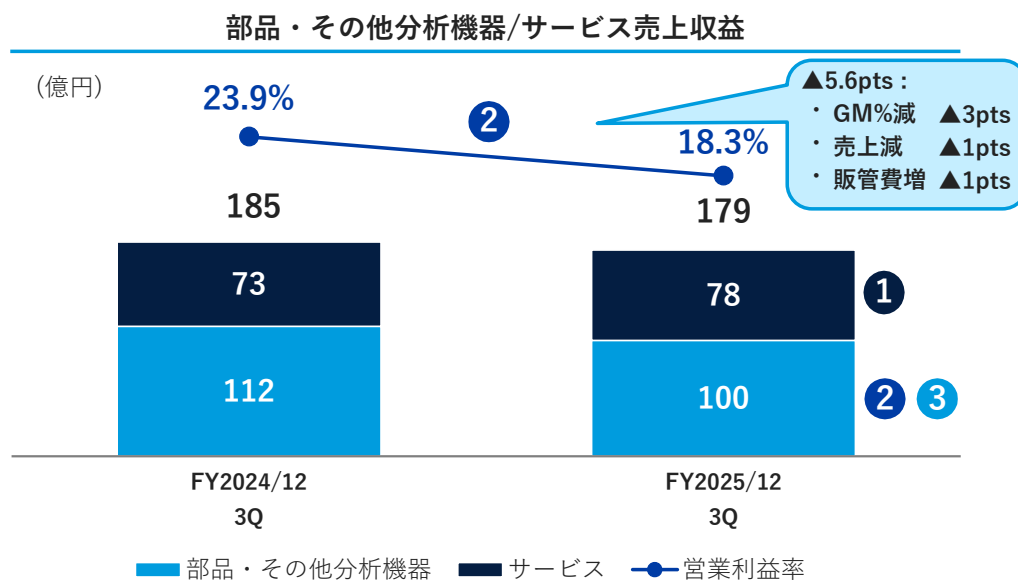


地域別売上収益



- ① ロジック：米州での低下による
- ② メモリ：市場の量産投資は遅れているが、アジアにおけるDRAM・NANDが牽引し、前年対比で大幅に伸長
- ③ 製品・地域Mixの影響によるGM率の低下、売上減、R&D等の戦略投資による販管費増により、営業利益率は一時的にYoY18pts低下。ただし4Qは大幅なボリューム増と高採算案件が集中、年間の営業利益率は30%+のレベルに向上する見込み

- 3Q累計売上高はYoY▲3.7%。 EUV向け多層膜ミラーを除けば+2%
- サービス売上は+7%の成長

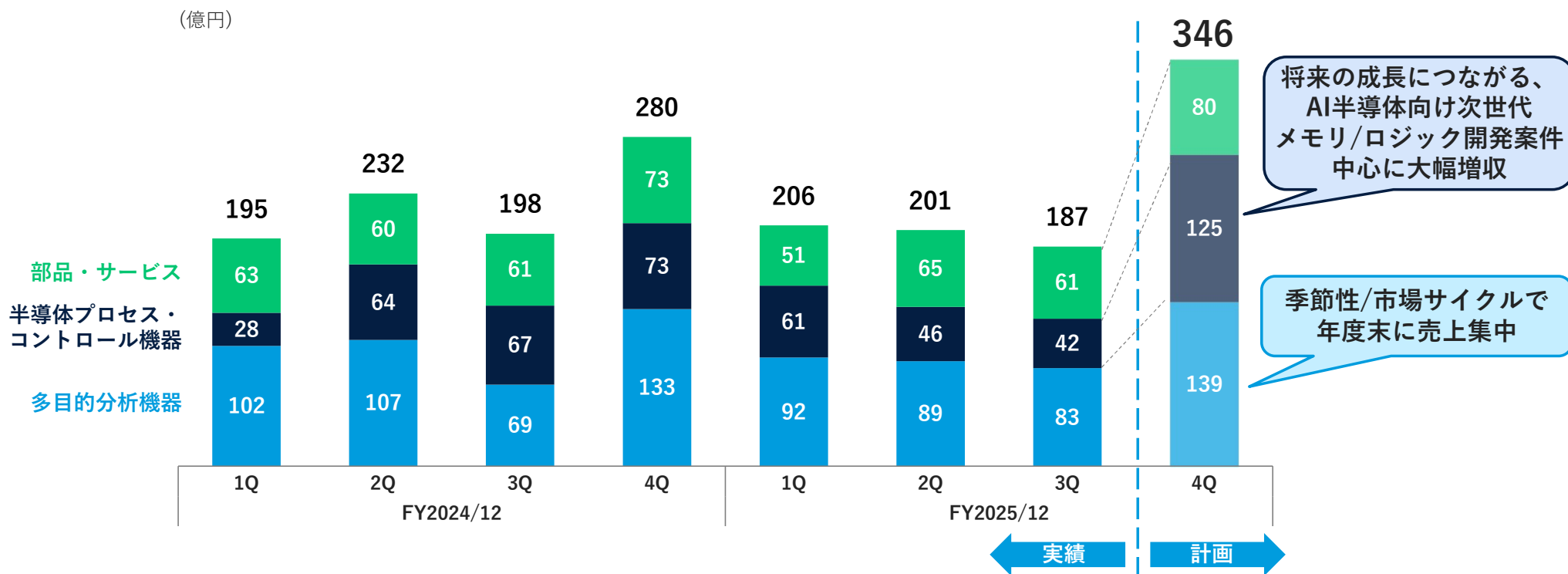


- ① サービス：価格引き上げとグローバルでの保守サービス契約の拡販、インストールベースの増大により堅調に成長
- ② EUV向け多層膜ミラー：売上(▲11億円)。営業利益率の低下にも影響
- ③ EUV以外の部品・その他分析機器：累計では対前年でほぼフラットにまで戻る。4Qに向けて好転へ

# Rigaku 2025年通期業績予想達成に向けた進捗

- 3Qは全体で事前の想定範囲内に着地
- 半導体プロセス・コントロール機器の3Qは想定を上回る進捗
- 部品・サービス、多目的分析機器は想定線で進捗、4Qは全体で計画通り大幅増収を達成できる見込み

四半期別売上高推移／予想



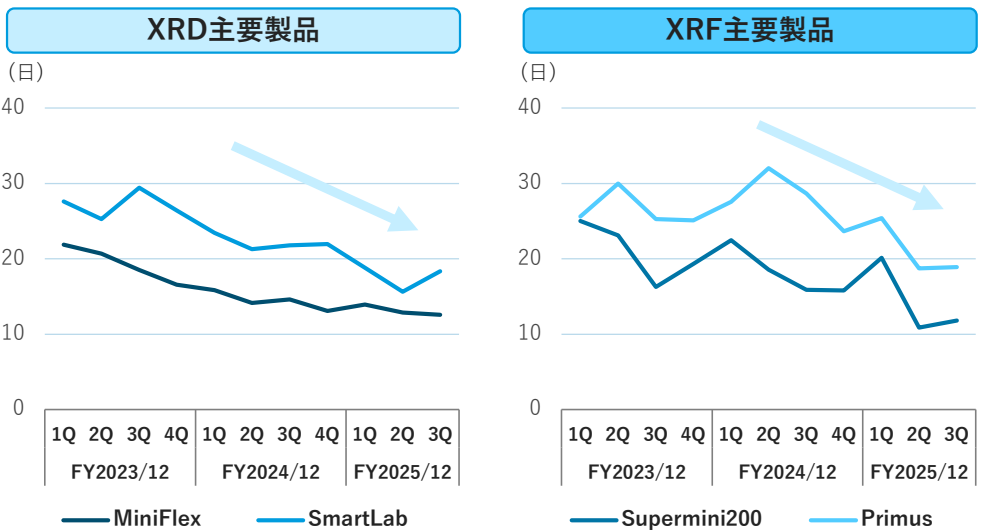
多目的分析機器

部品・サービス

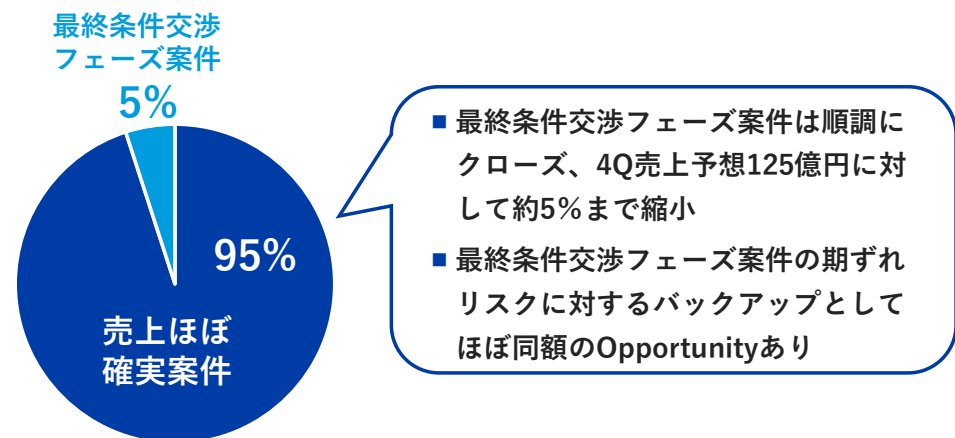
2025年度予想売上高の達成に向けて：

- 受注およびサプライチェーンの準備はほぼ完了 (工場出荷売上ベースでは目標達成)
- リードタイムは大幅に改善、売上目標達成を支える

主要製品のリードタイム実績推移



半導体プロセス・コントロール機器



4Q売上の内容：

- 2025年度4Q時点で約50億円がJEP<sup>(1)</sup>機として顧客に導入され評価中。約半分が2025年度4Q末で完了する予定で、顧客との認識のずれは無し
- 加えて、約35億円が新製品売上(MFM GEN4、T-SAXS等)

注：  
1. Joint Evaluation Programの略称。新技術の評価を行うために、購入契約に先立ち顧客サイトに装置を導入し、要求される性能を有するかを合同で確認するプロセス。確認できれば当装置の購入に繋がり、売上計上に伴い固定資産から売上原価に振り替えられる。

業績予想達成に必要な  
4Q業績 & 利益率

利益率見通し

多目的分析機器

売上収益 : **139億円**  
 営業利益 : **33億円**  
 営業利益率 : **24%**

- 2024年度4Qに営業利益率25%の実績あり
- 2025年度3Q累計GM%はYoYで改善 (+約1pt)
- 2025年度4Qも高GM%案件あり(日本/EMEA/US)
- YoY減収でSG&A/売上高比率悪化が一部相殺

半導体プロセス・  
コントロール機器

売上収益 : **125億円**  
 営業利益 : **68億円**  
 営業利益率 : **55%**

- 4Q売上高の約2割はJEP<sup>(1)</sup>完了予定案件。JEP機は製品原価の一部が償却済のため極めて高GM%
- さらに、4Q売上高の約3割は高GM%の新製品案件
- 低マージンの個別案件無し。案件積み上げベースで75%程度のGM%見通し

部品・サービス

売上収益 : **80億円**  
 営業利益 : **14億円**  
 営業利益率 : **18%**

- 案件積み上げでベースで必要なマージンを確保可能な見通し

追加的アクション

通期業績予想ベースからSG&A費用削減施策を実施中

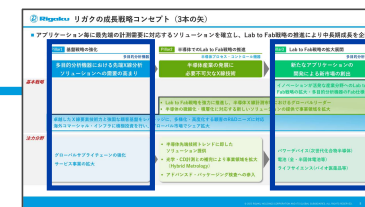
- 人員採用ペースダウン
  - プロモーション/広告宣伝
  - 旅費、その他経費等
- ただし、将来成長に向けたR&D活動は継続

注:

1. Joint Evaluation Programの略称。新技術の評価を行うために、購入契約に先立ち顧客サイトに装置を導入し、要求される性能を有するかを合同で確認するプロセス。確認できれば当装置の購入に繋がりが、売上計上に伴い固定資産から売上原価に振り替えられる。

## 2. 成長戦略アップデートと2026年度の方向性

---



■ アプリケーション毎に最先端の計測需要に対応するソリューションを確立、Lab to Fab戦略の推進

**Pillar1** 基盤戦略の強化

基本戦略

- X線要素技術力と強固な顧客基盤をレバレッジに、多様化・高度化する顧客のR&Dニーズに対応
- 海外コマース・インフラに積極投資を行い、グローバル市場でシェア拡大

取り組みアップデート

■ 高分子材料向け新製品の発表

- ・ 高分子構造評価X線回折システム「DicifferX WAXS Edition」



■ MI (マテリアル・インフォマティクス)

- ・ 国内外の大学・民間ラボとの自動・自律実験で9案件獲得/受注
- ・ MIのさらなる進化に向けてビジネス戦略を策定中

【材料開発プロセスのAI/自動化のイメージ】



**Pillar3** Lab to Fab戦略の拡大展開

- イノベーションが活発な産業分野へのLab to Fab戦略の拡大・多目的分析機器のFab仕様化

■ 微小部蛍光X線分析装置 新製品の発表

- ・ 半導体、電子材料や電池材料の解析「Qualana」



■ Fab向け自動化ソリューションの海外拡販

- ・ セメント業界：中国で2件受注、欧州でも拡販体制の整備進む
- ・ マイニング業界：南米やアジアをターゲットに大手企業での横展開狙う

■ 次世代電池：ペロブスカイト太陽電池、全固体電池向けソリューション案件で受注獲得

■ パワーデバイス：AIデータセンター電源用途にSiC、GaN系デバイスの採用検討で、関連した引き合いが増加

■ ライフサイエンス：電子密度トポグラフィ技術搭載「BioMAXS/EDT」初号機は大阪公立大学に納品完了。現在、製品名「MoleQlyze」として多数のリード獲得、国内外20社以上のデモ/受託解析の引き合いに対応中



■ 3Qにて、先端半導体ロードマップにおける「ロジック・メモリ」の製品採用に進捗

先端半導体計測ニーズに向けた開発・ロードマップ(FY2025 2Q決算発表再掲)

	先端計測ニーズ	開発/上市ロードマップ			想定SAM (目標シェア) @2030	進捗
		2025年	2026年	2027年		
ロジック	▪ GAA/CFET 3D構造形状計測	次世代ロジック XTRAIA CD-3200G (低エネルギーGI-SAXS) 開発中			★本格量産開始	新市場 100M\$(>50%) ▪ CD-3000G販売中 ▪ 低E版CD-3200G開発中
ロジック・メモリ共通	1 Si/SiGe超格子計測 2 High-k/Metal Gate 超薄膜計測 3 軽元素超薄膜計測	次世代ロジック・メモリ共通				
		XTRAIA XD (HR-XRD) 顧客評価中			★本格量産開始	100M\$(>70%) ▪ 開発完了、大手ファウンドリ(メモリで採用)
		XTRAIA MF-3400(XRF/XRD複合機GEN4) 開発中			★本格量産開始	200M\$(>70%) ▪ 次世代機(GEN4)開発中
		ONYX 3200 開発中			★本格量産開始	新市場 100M\$(>50%) ▪ 軽元素XRF開発完了、製品化中
メモリ	▪ DRAM/NAND HAR(深孔)計測	次世代メモリ XTRAIA CD-3200(T-SAXS) 顧客評価			★本格量産開始	100M\$(>50%) ▪ 大手メモリ・WFE採用
アドバンスド・パッケージング	▪ HBM/CoWoS等の先端パッケージの微細バンプ/TSV等の欠陥検査	AXI(Advanced X-ray Inspection) アルファ機デモ中 ベータ機開発中			ベータ機顧客評価	★本格量産開始 300M\$(>30%) ▪ アルファ機デモ中 ▪ ベータ機開発中
Hybrid Metrology	▪ ロジック、メモリ 立体構造形状計測	T-SAXS 顧客評価 X線と光学手法を組み合わせ解析するハイブリッド・エンジン開発中			★本格量産開始	新市場 100M\$(>50%) ▪ 光学パートナーと共同開発
		GI-SAXS : 開発予定			★	

3Qにおける主なアップデート

「ロジック・メモリ共通」における製品採用

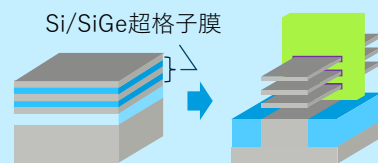
- 1 Si/SiGe超格子計測**
  - 開発完了、大手ファウンドリ・メモリで既に採用済み
  - 当社製品の特長、強み(次頁)
- 2 High-k/Metal Gate 超薄膜計測**
  - 次世代機(GEN4)開発完了、大手メモリ採用決定
  - 当社製品の特長、強み(次頁)
- 3 軽元素超薄膜計測**
  - 軽元素XRF開発完了、大手ロジック採用決定

■ 高度化が進む先端ロジック、次世代メモリの製造プロセスにおいて、独自の技術で圧倒的優位性を実現

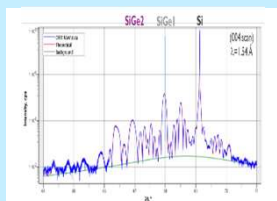
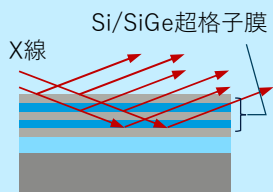
### 1 Si/SiGe超格子計測

■ GAA/CFET、3DDRAM、HBMに必須なSi/SiGe超格子膜のHR-XRDとXRRによる高精度計測装置「XTRAI A XD-3300」

- ・微小スポット・高分解能X線光学系による製品ウエハ測定 **リガクの独自技術**
- ・遺伝的アルゴリズムを使った高度解析ソフトによる多層膜各層の膜厚・組成解析 **リガクの独自技術**



GAA Si/SiGe構造



Si/SiGe超格子膜 HR-XRD+XRR解析

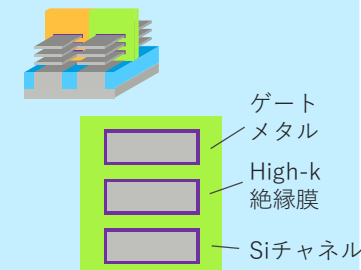


微小スポットX線光学系

### 2 High-k/Metal Gate (HKMG) 超薄膜計測

■ 先端半導体に用いられるHKMG薄膜材料 (Ti、Hf、La他)のXRFによるナノレベル膜厚・組成計測装置「XTRAI A MF-3400」

- ・X線強度2倍の新X線源、高速搬送・位置決め機構により計測スループット\*最大2倍を実現 **リガクの独自技術**  
\*処理能力
- ・微小スポット・高分解能光学系による製品ウエハ測定 **リガクの独自技術**



GAA HKMG構造



強度2倍 X線源



測定スループット\*向上

## 京都大学 北川 進 特別教授 ノーベル化学賞受賞

- 京都大学・北川研究室における、物質の精密な構造解析および金属有機構造体(MOF: Metal-Organic Framework)をはじめとする多孔性材料の開発など多数の成果創出を当社製品が長年にわたり支援



北川 進 京都大学 理事・副学長 特別教授

注：  
1. 2025年9月4日公表

## リガク／日本電子—iCeMSイノベーションコア設置<sup>(1)</sup>

- 京都大学、当社、日本電子株式会社が連携し、電子線・X線による複合構造解析技術の革新と新規材料の機能探索加速を目指す共同研究拠点の設置に関する協定を締結

## 「リガクグループ 統合報告書2025」発行



<https://rigaku-holdings.com/ir/reports/>

■ 半導体プロセス・コントロール機器事業が成長を牽引、中期計画達成に沿った成長軌道を維持

環境認識

多目的分析機器

- 2025年は一過性の要因で踊り場、2026年に反転
  - ・ 2024年の中国補正予算の好影響、およびEV向けSiC需要急増の2025年反動減は終了
  - ・ 米国アカデミア予算削減影響が残るものの、イノベーションへの需要は旺盛

半導体プロセス・コントロール機器

- AIの浸透・進化がドライバーとなり、世界の半導体投資が足元で加速
  - ・ メモリ増産：DRAMはHBMが牽引、NANDにも高速化の波
  - ・ 次世代ロジック・メモリの開発需要は引き続き旺盛、2025年度を上回るJEP<sup>(1)</sup>を予定

部品・サービス

- 事業環境は好転へ、EUVの穴を埋める
  - ・ 製品販売拡大に伴うサービスの順調と、その他分析機器の防衛・セキュリティ向け好調によりEUV向け部品不振をカバー

戦略

■ 安定成長に回帰

- ・ 海外コマース・インフラに積極投資を行い、グローバル市場でシェア拡大
- ・ MI向け自動化/AIニーズを取り込み案件獲得を加速
- ・ 米国ではインダストリー（GAFAM、エネルギー関係等）にリソースシフトして事業強化

■ 中計ガイダンスを上回る成長を目指す

- ・ ロードマップに沿って次世代ロジック・メモリ向け新製品の出荷開始
- ・ メモリの増産需要増を新製品で取り込み
- ・ 海外顧客サポートの強化で次世代品開発加速を支援（RTC：シリコンバレー、台湾に続きその他アジア地域に展開）

■ EUV需要の回復を前提としない事業成長を図る

- ・ 保守契約の拡大でサービスの成長継続
- ・ EUVに代わる部品・その他分析機器強化（熱分析、携帯型ラマン、PCI等）

注：

1. Joint Evaluation Programの略称。新技術の評価を行うために、購入契約に先立ち顧客サイトに装置を導入し、要求される性能を有するかを合同で確認するプロセス。確認できれば当装置の購入に繋がりが、売上計上に伴い固定資産から売上原価に振り替えられる。

## 自己株式取得について

当社では、現在の株価水準は当社の将来の収益性を十分に織り込んでいないと認識しており、持続的な企業価値向上に向けた取り組みの一環として、また資本政策及び株主還元策強化の観点から、自己株式を最大40億円取得する方針

- 取得対象株式の種類：普通株式
- 取得し得る株式の総数：6,000,000株(上限)  
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.62%)
- 株式取得価額の総額：4,000百万円(上限)
- 取得期間：2025年8月8日～2025年12月23日
- 取得方法：東京証券取引所における市場買付け(取引一任契約)
- 取得した自己株式は、原則として消却処理することを想定

## 配当性向について

当社は、中長期の経営視点から成長投資の推進と財務健全性の確保とのバランスを考慮しつつ、各期の業績に応じて当期連結利益の30%を目途に株主への配当を実施していくことを、引き続き基本方針とする

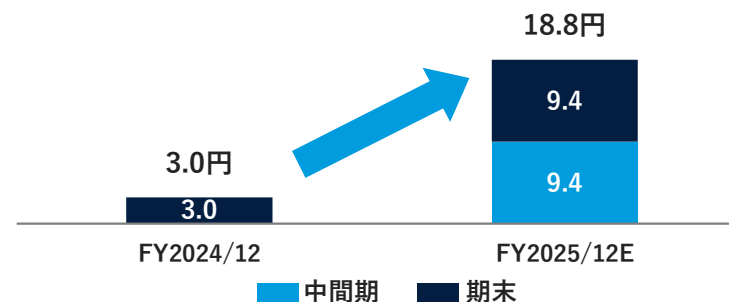
- 2025年上期配当は計画通り1株当たり9.4円で実施
- 2025年期末配当は当初計画通り1株当たり9.4円、年間で18.8円の予定

注：  
1. 2025年11月4日付適時開示「自己株式の取得状況に関するお知らせ」に基づく  
2. FY2024/12の配当金は2024年10月24日上場後2か月分に相当

## 自己株式の取得状況<sup>(1)</sup>

- 2025年10月31日現在の取得状況
  - ・ 取得期間：2025年8月8日～2025年10月31日
  - ・ 取得した累計株式数：2,771,900株
  - ・ 株式取得額の総額：2,455,935,270円

## 配当金の推移<sup>(2)</sup>



## 今期：修正後の計画線に沿った着地見込み

- **多目的分析機器事業**：3Qから回復基調。4Qは季節性もあり売上拡大
- **半導体プロセス・コントロール機器事業**：次世代メモリ/ロジック開発案件中心に4Qは予定通り大幅増収見込み、新製品の売上貢献もスタート

## 来期：中期計画達成に沿った成長軌道を維持

- **多目的分析機器事業**：事業環境の底打ちで安定成長に回帰、米政策によるアカデミア影響をインダストリー向けでカバーできる事業構造構築を継続
- **半導体プロセス・コントロール機器事業**：AIの浸透・進化による追い風を背景に中計ガイダンスを上回る成長を目指す
- **部品・サービス**：サービス、部品・その他分析機器の拡大でEUV需要の回復を前提としない成長を図る

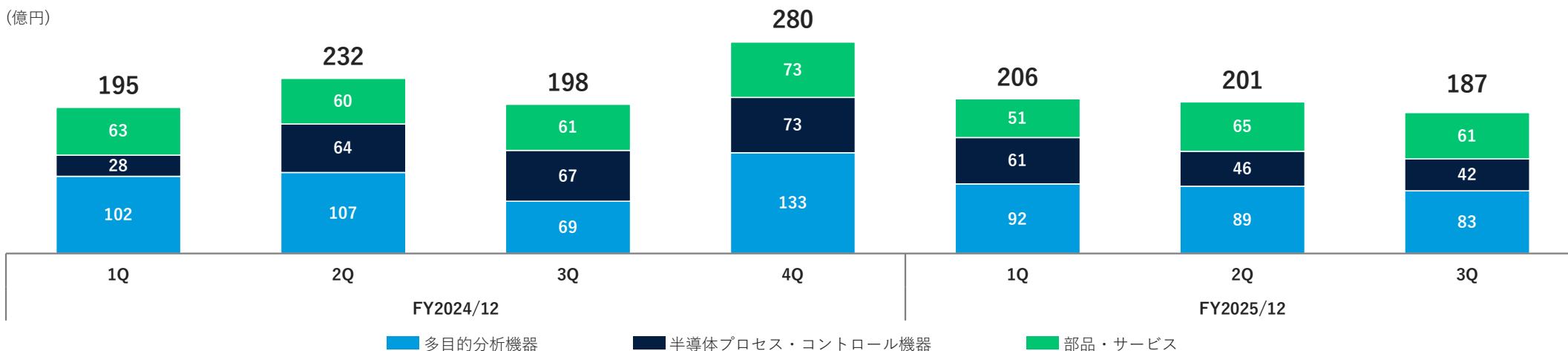
中長期成長：新製品開発は順調で生産拡大に向けた投資も完了、収益貢献も開始  
中計の戦略に変更なし、中長期の企業価値向上に向けて邁進

## Appendix - 2025年12月第3四半期連結決算

---

(百万円)	売上収益				営業利益				営業利益率		
	FY2024/12 3Q累計	FY2025/12 3Q累計	増減	増減率	FY2024/12 3Q累計	FY2025/12 3Q累計	増減	増減率	FY2024/12 3Q累計	FY2025/12 3Q累計	増減
多目的分析機器	27,988	26,493	(1,495)	(5.3)%	3,892	3,043	(849)	(21.8)%	13.9%	11.5%	(2.4)pts
半導体プロセス・ コントロール機器	15,995	15,094	(901)	(5.6)%	5,432	2,373	(3,059)	(56.3)%	34.0%	15.7%	(18.3)pts
部品・サービス	18,596	17,908	(688)	(3.7)%	4,436	3,282	(1,154)	(26.0)%	23.9%	18.3%	(5.6)pts
本社費	-	-	-	-	(1,912)	(2,136)	(224)	11.7%	-	-	-
売上収益合計	62,580	59,496	(3,084)	(4.9)%	11,849	6,562	(5,287)	(44.6)%	18.9%	11.0%	(7.9)pts

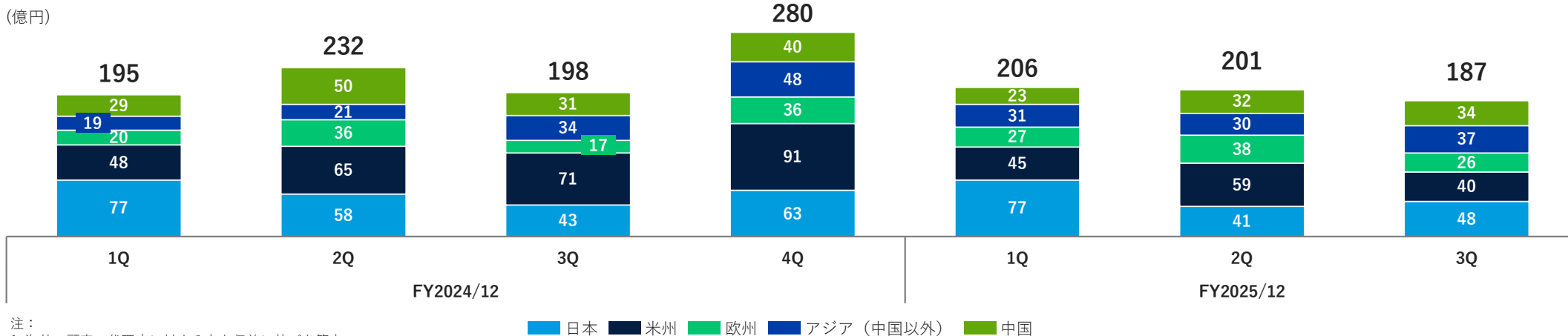
製品別売上収益推移





(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減	増減率	主たる増減要因
	3Q累計	3Q累計			
売上収益合計	62,580	59,496	(3,084)	(4.9)%	-
日本	17,987	16,691	(1,296)	(7.2)%	多目的分析機器と部品・サービスにおけるEUV向け多層膜ミラーの減収。半導体プロセス・コントロールは増収
米州	18,559	14,610	(3,949)	(21.3)%	部品・サービスにおけるEUV向け多層膜ミラーの減速、及び半導体プロセス・コントロール前期大型案件の剥落で減収
欧州	7,442	9,212	1,770	23.8%	主に多目的分析機器における汎用機の好調な販売により増収
アジア(中国以外)	7,540	9,976	2,436	32.3%	主に半導体プロセス・コントロール機器事業が貢献
中国	11,050	9,005	(2,045)	(18.5)%	主に多目的分析機器において前期増加した中国補正予算案件の剥落により減少

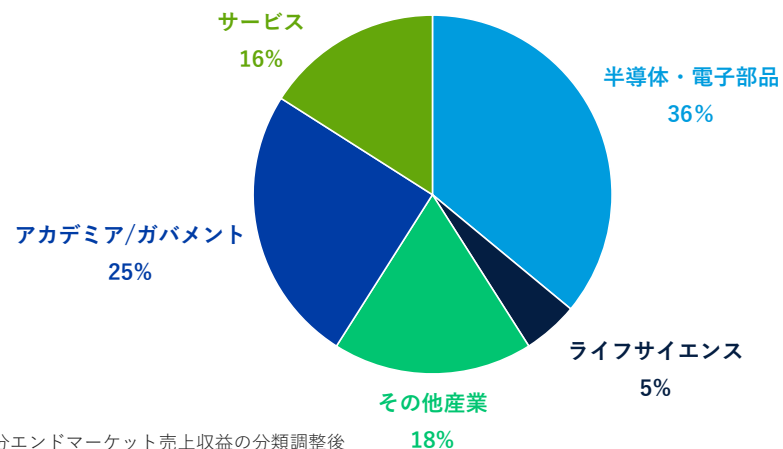
## 地域別売上収益推移



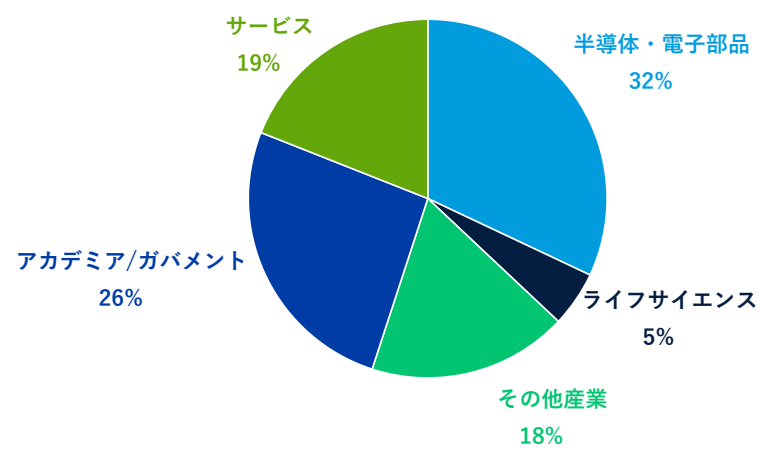
**Rigaku** エンドマーケット別売上<sup>(1)</sup>(管理会計ベース)

(百万円)	FY2024/12	売上収益比率	FY2025/12	売上収益比率	コメント
	3Q累計 <sup>(1)</sup>		3Q累計		
売上収益合計	62,580	100%	59,496	100%	–
半導体・電子部品	22,684	36%	18,942	32%	EUV向け多層膜ミラーおよび多目的分析機器におけるパワー半導体向け大型製品の売上低下による影響で減少
ライフサイエンス	2,925	5%	3,128	5%	–
その他産業	11,358	18%	10,622	18%	–
アカデミア/ガバメント	15,667	25%	15,715	26%	前期は中国補正予算案件を含むが、欧州における売上伸長により増加
サービス	9,942	16%	11,087	19%	Installベースの増大による着実な成長

2024/12月期 3Q累計<sup>(1)</sup>



2025/12月期 3Q累計



注：  
1. 過年度分エンドマーケット売上収益の分類調整後

(百万円)	2024/12 3Q累計	2025/12 3Q累計	増減	増減率	主たる増減要因
売上収益	62,580	<b>59,496</b>	(3,083)	(4.9)%	多目的分析機器事業における中国補正予算案件で前期増加した反動減、半導体プロセスコントロールの第3四半期末時点における前期大口案件の剥落、および部品・サービス事業でのEUV関連取引減少により減収
売上総利益 <sup>(1)</sup>	36,142	<b>32,465</b>	(3,676)	(10.2)%	多目的分析機器、半導体プロセス・コントロール機器事業における地域・販売製品ミックスの影響、およびGM率の高いEUV向け多層膜ミラーの売上減により低下
対売上収益比率	57.8%	<b>54.6%</b>	(3.2)pts	-	
営業利益	11,849	<b>6,562</b>	(5,287)	(44.6)%	売上総利益の低下に加え、戦略的な研究開発費、人員・ITなどのインフラ強化費用、半導体プロセス・コントロール機器事業での代理店販売割合増による販売手数料、および為替差損の増加が影響
対売上収益比率	18.9%	<b>11.0%</b>	(7.9)pts	-	
税引前四半期利益	11,544	<b>6,095</b>	(5,449)	(47.2)%	
四半期利益	8,990	4,273	(4,716)	(52.5)%	海外拠点との利益比率及び税率差異による影響などによる法人税等負担増加
<b>Non-IFRS 指標</b>					
調整後四半期利益 <sup>(2)</sup>	10,231	<b>5,262</b>	(4,969)	(48.6)%	
調整後EPS	45.4	<b>22.8</b>	(22.6)	(49.7)%	
EBITDA	15,436	<b>10,321</b>	(5,115)	(33.1)%	
調整後EBITDA	15,545	<b>10,252</b>	(5,293)	(34.0)%	
対売上収益比率	24.8%	<b>17.2%</b>	(7.6)pts	-	
研究開発費	4,732	<b>5,371</b>	639	13.5%	研究開発投資促進
対売上収益比率	7.6%	<b>9.0%</b>	1.5pts	-	
設備投資額	3,619	<b>5,094</b>	1,474	40.7%	山梨工場増設およびデモ機の取得
対売上収益比率	5.8%	<b>8.6%</b>	2.8pts	-	
フリーキャッシュ・フロー	4,872	<b>204</b>	(4,667)	(95.8)%	
JPY/USD	151.6	<b>147.8</b>	(3.8)	(2.5)%	第3四半期累計の為替影響額(対前年比)：売上 ▲約4億円、EBITDA ▲約1億円
JPY/EURO	164.6	<b>165.6</b>	1.0	0.6%	

注：

- 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での修理・納入等フィールドサービス関連費用を売上原価で計上する方法に変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用(2,120百万円を販売費及び一般管理費から売上原価に変更)して表示
- Non-IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage30、31に詳細を記載

(百万円)	FY2024/12				FY2025/12									
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	1Q	2Q	3Q	前年同期比	増減率	前四半期比	増減率	3Q累計	前年同期比	増減率
売上収益	19,537	23,241	<b>19,801</b>	<b>62,580</b>	20,614	20,141	<b>18,740</b>	(1,061)	(5.4)%	(1,401)	(7.0)%	<b>59,496</b>	(3,084)	(4.9)%
売上総利益 <sup>(1)</sup>	10,607	13,806	<b>11,728</b>	<b>36,142</b>	11,590	11,135	<b>9,739</b>	(1,989)	(17.0)%	(1,396)	(12.5)%	<b>32,465</b>	(3,677)	(10.2)%
対売上収益比率	54.3%	59.4%	<b>59.2%</b>	<b>57.8%</b>	56.2%	55.3%	<b>52.0%</b>	(7.3)pts	-	(3.3)pts	-	<b>54.6%</b>	(3.2)pts	-
営業利益	3,160	5,511	<b>3,176</b>	<b>11,849</b>	2,835	2,882	<b>844</b>	(2,332)	(73.4)%	(2,038)	(70.7)%	<b>6,562</b>	(5,287)	(44.6)%
対売上収益比率	16.2%	23.7%	<b>16.0%</b>	<b>18.9%</b>	13.8%	14.3%	<b>4.5%</b>	(11.5)pts	-	(9.8)pts	-	<b>11.0%</b>	(7.9)pts	-
税引前利益	3,036	5,409	<b>3,098</b>	<b>11,544</b>	2,741	2,704	<b>649</b>	(2,449)	(79.1)%	(2,055)	(76.0)%	<b>6,095</b>	(5,449)	(47.2)%
当期利益(四半期/中間)	2,185	4,322	<b>2,482</b>	<b>8,990</b>	1,918	1,860	<b>494</b>	(1,988)	(80.1)%	(1,366)	(73.4)%	<b>4,273</b>	(4,717)	(52.5)%
<b>Non-IFRS 指標</b>														
調整後当期利益(四半期/中間) <sup>(2)</sup>	2,602	4,741	<b>2,887</b>	<b>10,231</b>	2,265	2,157	<b>839</b>	(2,048)	(70.9)%	(1,318)	(61.1)%	<b>5,262</b>	(4,969)	(48.6)%
対売上収益比率	13.3%	20.4%	<b>14.6%</b>	<b>16.3%</b>	11.0%	10.7%	<b>4.5%</b>	(10.1)pts	-	(6.2)pts	-	<b>8.8%</b>	(7.5)pts	-
調整後EPS	11.6	21.0	<b>12.8</b>	<b>45.4</b>	9.8	9.4	<b>3.6</b>	(9.2)	(71.6)%	(5.7)	(61.1)%	<b>22.8</b>	(22.6)	(49.7)%
EBITDA	4,334	6,744	<b>4,357</b>	<b>15,436</b>	4,030	4,104	<b>2,185</b>	(2,172)	(49.9)%	(1,919)	(46.8)%	<b>10,321</b>	(5,115)	(33.1)%
調整後EBITDA	4,355	6,775	<b>4,413</b>	<b>15,545</b>	4,030	4,036	<b>2,185</b>	(2,228)	(50.5)%	(1,851)	(45.9)%	<b>10,252</b>	(5,293)	(34.0)%
対売上収益比率	22.3%	29.2%	<b>22.3%</b>	<b>24.8%</b>	19.6%	20.0%	<b>11.7%</b>	(10.6)pts	-	(8.4)pts	-	<b>17.2%</b>	(7.6)pts	-
研究開発費	1,449	1,716	<b>1,565</b>	<b>4,732</b>	1,653	1,866	<b>1,851</b>	286	18.3%	(15)	(0.8)%	<b>5,371</b>	639	13.5%
対売上収益比率	7.4%	7.4%	<b>7.9%</b>	<b>7.6%</b>	8.0%	9.3%	<b>9.9%</b>	2.0pts	-	0.6pts	-	<b>9.0%</b>	1.5pts	-
設備投資額	520	2,323	<b>775</b>	<b>3,619</b>	625	3,468	<b>1,000</b>	225	29.0%	(2,468)	(71.2)%	<b>5,094</b>	1,475	40.8%
対売上収益比率	2.7%	10.0%	<b>3.9%</b>	<b>5.8%</b>	3.0%	17.2%	<b>5.3%</b>	1.4pts	-	(11.9)pts	-	<b>8.6%</b>	2.8pts	-
フリーキャッシュ・フロー	1,605	3,357	<b>(90)</b>	<b>4,872</b>	489	2,359	<b>(2,643)</b>	(2,553)	2836.7%	(5,002)	(212.0)%	<b>204</b>	(4,668)	(95.8)%
JPY/USD				<b>151.6</b>	151.2							<b>147.8</b>		
JPY/EURO				<b>164.6</b>	159.4							<b>165.6</b>		

注:

- 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での修理・納入等フィールドサービス関連費用を売上原価で計上する方法に変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用(2,120百万円を販売費及び一般管理費から売上原価に変更)して表示
- Non-IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage30、31に詳細を記載

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減	増減率	主たる増減要因
	期末	3Q末			
流動資産	71,228	64,510	(6,718)	(9.4)%	前年度期末からの営業債権等の回収による
(現預金)	27,992	21,358	(6,633)	(23.7)%	
有形固定資産	19,287	22,079	2,791	14.5%	山梨工場増設、デモ機の取得
無形資産	87,030	87,335	304	0.4%	
資産合計	177,547	173,925	(3,621)	(2.0)%	
流動負債	29,934	28,589	(1,344)	(4.5)%	期末からの債務支払い、未払法人所得税の支払い、契約負債の減少等による
非流動負債	65,843	63,753	(2,089)	(3.2)%	長期借入金の一年以内返済借入への振替による減少
(有利子負債総額)	61,601	60,633	(968)	(1.6)%	
純資産	81,769	81,581	(188)	(0.2)%	利益による増加、新株予約権行使による増加、配当金支払による減少、為替換算調整による減少
負債・純資産合計	177,547	173,925	(3,621)	(2.0)%	
ネットデット/ 調整後EBITDA <sup>(1)</sup>	1.4x	2.2x	-	-	
自己資本比率	46.1%	46.9%	-	-	

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減	増減率	主たる増減要因
	3Q累計	3Q累計			
営業キャッシュ・フロー	8,213	5,296	(2,917)	(35.5)%	売上低下の影響を、債権回収の最善化努力により軽減
投資キャッシュ・フロー	(3,341)	(5,091)	(1,750)	52.4%	山梨工場の増設をはじめとした有形および無形固定資産の増加
フリーキャッシュ・フロー	4,872	204	(4,667)	(95.8)%	
財務キャッシュ・フロー	(3,485)	(5,945)	(2,459)	70.6%	長期借入および新株予約券行使による収入、配当金支払
為替換算差異	(172)	(893)	(720)	-	現金および現金同等物の為替換算差額
ネットキャッシュ・フロー	1,214	(6,633)	(7,847)	(646.3)%	

注：

1. 2025年12月期第3四半期末の値はLTM合計の調整後EBITDAを用いて算出

 調整後利益等における調整項目(1/2)

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減
<b>EBITDA</b>	<b>3Q累計</b>	<b>3Q累計</b>	
税引前利益	11,544	6,095	(5,449)
減価償却費及び償却費	3,638	3,775	137
支払利息	509	783	273
受取利息及び配当金	(256)	(333)	(77)
<b>EBITDA</b>	<b>15,436</b>	<b>10,321</b>	<b>(5,115)</b>
利益率	24.7%	17.3%	(7.3)pts
<b>調整後EBITDA</b>	<b>3Q累計</b>	<b>3Q累計</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>15,436</b>	<b>10,321</b>	<b>(5,115)</b>
コンサルティング・フィー	22	-	(22)
中国免除申請関連費用	-	(68)	(68)
上場関連費用	85	-	(85)
<b>調整項目計</b>	<b>108</b>	<b>(68)</b>	<b>(176)</b>
<b>調整後EBITDA</b>	<b>15,545</b>	<b>10,252</b>	<b>(5,292)</b>
利益率	24.8%	17.2%	(7.6)pts

## 調整後利益等における調整項目(2/2)

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減
<b>調整後営業利益</b>	<b>3Q累計</b>	<b>3Q累計</b>	
<b>営業利益</b>	<b>11,849</b>	<b>6,562</b>	<b>(5,287)</b>
PPA償却費	1,728	1,544	(184)
コンサルティング・フィー	22	-	(22)
中国免除申請関連費用	-	(68)	(68)
上場関連費用	85	-	(85)
<b>調整項目計</b>	<b>1,837</b>	<b>1,476</b>	<b>(360)</b>
<b>調整後営業利益</b>	<b>13,686</b>	<b>8,038</b>	<b>(5,647)</b>
利益率	21.9%	13.5%	(8.4)pts
<b>調整後当期利益</b>	<b>3Q累計</b>	<b>3Q累計</b>	
<b>当期利益</b>	<b>8,990</b>	<b>4,273</b>	<b>(4,716)</b>
PPA償却費	1,728	1,544	(184)
コンサルティング・フィー	22	-	(22)
中国免除申請関連費用	-	(68)	(68)
上場関連費用	85	-	(85)
<b>調整項目計</b>	<b>1,837</b>	<b>1,476</b>	<b>(360)</b>
調整項目に対する税金等調整	(595)	(487)	108
<b>調整後当期利益</b>	<b>10,231</b>	<b>5,262</b>	<b>(4,969)</b>
利益率	23.9%	8.8%	(15.1)pts

## Appendix - 2025年度業績予想

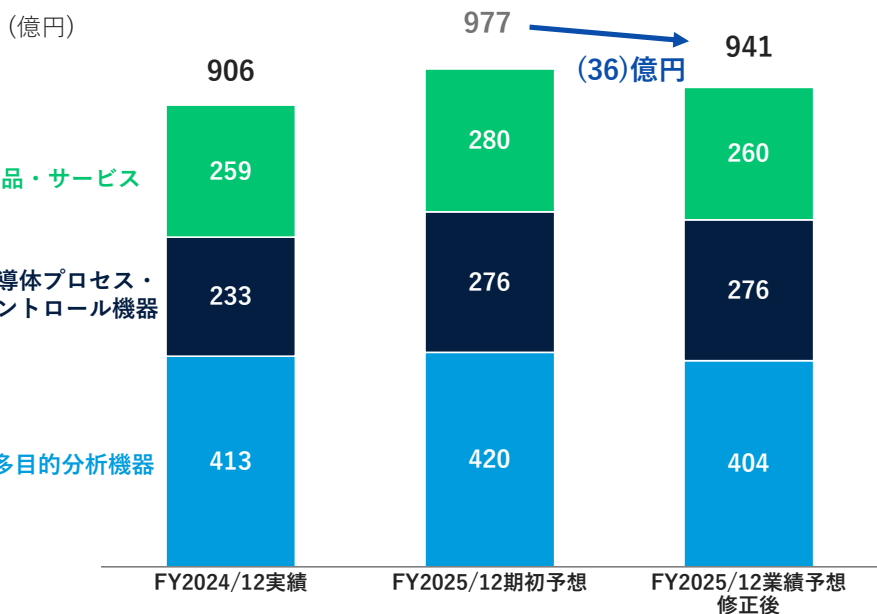
---



- 2025年度2Qに業績予想を小幅に下方修正(売上収益の実質成長率(YoY)：10%⇒6%)
- 米国政策によるアカデミア分野を中心とした米州市場への影響、EUV向け多層膜ミラーの短期的な需要調整が主因。一方で半導体プロセス・コントロール機器事業の見込みは不変

業績予想修正サマリー

製品別売上収益



注：  
1. 2025年8月7日に業績予想を修正

多目的分析機器

▲16億円

- 米政策影響に伴うアカデミア領域における歳出削減等の影響を織込み(▲19億円)
- 成長分野における取組み強化、Pillar 3戦略の加速を通じたパイプライン創出を継続

半導体プロセス・コントロール機器

不変

- 売上成長は当初業績予想から不変、前年比実質+20%の成長を維持
- 量産から次世代テクノロジーの研究開発へシフトするが、年間目標の達成に向けて順調に推移

部品・サービス

▲20億円

- EUV向け多層膜ミラーの需要スローダウン等による部品減収見込み(▲18億円)
- 米政策は米州アカデミアのサービス事業にも影響(▲2億円)

調整後EBITDA

- 売上総利益は主に米国における多目的分析機器およびEUVの売上減による低下
- R&D投資は継続。その他販管費コントロールにより+8億円

**リガクの成長性と戦略の有効性は不変**

 2025年度業績予想<sup>(1)</sup> (再掲)

	2024年12月期	2025年12月期	
	実績	業績予想修正前	業績予想修正後 <sup>(1)</sup>
売上収益	906億円	977億円	941億円
前年比成長率	13.5%	7.8%	3.8%
調整後EBITDA	234億円	250億円	231億円
調整後EBITDAマージン	25.9%	25.7%	24.5%
調整後営業利益	209億円	220億円	201億円
調整後営業利益率	23.0%	22.6%	21.4%
調整後当期利益	153億円	154億円	136億円
調整後当期利益率	17.0%	15.8%	14.5%
研究開発費比率	7.5%	8.1%	8.3%
設備投資額比率	7.0%	8.7%	9.7%
要員数	2,136人	2,308人	2,292人
1株当たり配当金	3.0円	18.8円	18.8円
JPY/USD	152.2	145.0	145.0
JPY/EURO	164.4	156.0	156.0

注：  
1. 2025年8月7日に業績予想を修正

## Appendix – 用語集

---

用語	説明
AXI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automated X-Ray Inspectionの略称。X線を用いた自動検査装置。電子基板や半導体内部の欠陥を非破壊で検出し、品質管理を効率化する</li> </ul>
CFET	<ul style="list-style-type: none"> <li>Complementary FET(CFET)は、N型FETとP型FETを垂直方向に積層して統合する次世代の半導体デバイス技術 現在主流のFinFETやGAA(Gate-All-Around)FETに続く技術として期待されている</li> </ul>
CoWoS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chip on Wafer on Substrateの略称。TSMCが開発した先進パッケージ技術の一つ。 複数のチップをシリコンインターポーザー上に実装し、基板に搭載することで、高速・大容量のデータ処理と省スペース化を実現</li> </ul>
DicifferX WAXS Edition	<ul style="list-style-type: none"> <li>高分子フィルム、繊維、薄膜などの材料における原子・分子構造、結晶相および分子配向を高精度かつ数秒以内に測定する先進的なX線分析装置</li> </ul>
Electron Density Topography (電子密度トポグラフィー)	<ul style="list-style-type: none"> <li>結晶内部の電子の分布(電子密度)を可視化する技術。これにより、材料の原子構造や結合の状態を詳細に調べることが可能</li> </ul>
EUV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extreme Ultravioletの略称。波長が約13.5nmの紫外線を指し、半導体製造の露光プロセスで使用される光源技術</li> </ul>
GAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gate-All-Aroundの略称。 トランジスタ技術の一種で、ゲートがすべての側面からチャンネルに接触、継続的な小型化を可能にするトランジスタ構造を指す</li> </ul>
GaN	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガリウム(Ga)と窒素(N)で構成される化合物半導体材料</li> </ul>
GI-SAXS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grazing Incidence Small-Angle X-ray Scatteringの略称。浅い角度の斜め方向からX線を照射し、材料表面近くの微細構造を非破壊で解析する手法。薄膜や表面のナノスケール構造の評価に利用される</li> </ul>
HBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>High Bandwidth Memoryの略称。低消費電力かつ極めて広い帯域幅を持つ新型メモリチップ。 スタック内およびメモリとロジックの間の両方で、極めて広いデータチャンネルを提供する標準化された積層メモリ技術</li> </ul>

用語	説明
High-k/Metal Gate	<ul style="list-style-type: none"> <li>High-k材料とは高誘導率(high dielectric constant)を持つ材料のこと。High-k/Metal Gateとは、High-k材料と金属ゲートを組み合わせた最新のトランジスタ構造を指す</li> </ul>
MiniFlex XpC	<ul style="list-style-type: none"> <li>X線回折(XRD)を用いて材料の結晶構造を分析するためのコンパクトな装置であるMiniFlexシリーズに比べ、プロセス用途や自動化ラインとの連携を意識して開発されたモデル</li> </ul>
NEX CG II	<ul style="list-style-type: none"> <li>次世代偏光光学系エネルギー分散型蛍光X線分析装置。各種油類や液体、固体、金属、ポリマー、生体試料、粉末試料、ペースト試料、コーティング試料、薄膜試料など、さまざまな種類の試料の主成分および微量成分に対し、迅速に定性分析および定量分析や膜厚測定ができる</li> </ul>
ONYXシリーズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>エネルギー分散型蛍光X線分析(EDXRF)技術と光学技術を組み合わせたハイブリッド型分析装置。半導体パッケージなどの多層構造を非破壊でインライン評価可能。微小部の成分分析や3次元形状の測定に対応</li> </ul>
Perovskite Solar Cell (ペロブスカイト太陽電池)	<ul style="list-style-type: none"> <li>「ペロブスカイト構造」と呼ばれる結晶を使った次世代型の太陽電池。軽量・低コストで製造でき、高効率な発電が可能のため、シリコンに代わる有力な材料として研究・開発が進んでいる</li> </ul>
Pillar 3戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>リガクが推進する「Lab to Fab戦略」のもと、多目的分析機器の活用領域を、研究開発用途から量産工程へと拡大・展開する取り組み</li> </ul>
Qualana	<ul style="list-style-type: none"> <li>高い分析精度を備え、位置ずれのない微小領域および広域マッピングを高精度に実現する先進的なX線分析装置。軽元素までも高感度で検出し、リガク独自のFPプログラムにより、柔軟な薄膜定量分析をサポート</li> </ul>
SiC	<ul style="list-style-type: none"> <li>シリコン(Si)と炭素(C)で構成される化合物半導体材料</li> </ul>

用語	説明
SiGe	<ul style="list-style-type: none"> <li>シリコン(Si)にゲルマニウム(Ge)で構成される合金半導体材料</li> </ul>
TFXRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体産業における薄膜特性の高精度な評価を目的としたX線回折(XRD)装置。特に、200mmおよび300mmの大口径ウェーハ上の薄膜の測定に対応しており、研究開発から製造プロセスのモニタリングまで幅広く利用されている</li> </ul>
T-SAXS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmissive Small-Angle X-ray Scatteringの略称。透過型小角X線散乱法。物質にX線を透過させ、その散らばり方を分析することで、物質内部のナノメートルスケールの微細構造を非破壊で解析できる手法。半導体部品内部の微細な状態を詳しく確認する際に用いられる</li> </ul>
WFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wafer Fab Equipment の略称。ウェーハを回路形成・検査するプロセスにおける製造装置を指す</li> </ul>
XRD (回折)	<ul style="list-style-type: none"> <li>X線回折(XRD)。結晶試料にX線を照射するときに生じる回折パターンから試料の結晶構造情報を得る手法</li> </ul>
XRF (蛍光)	<ul style="list-style-type: none"> <li>X-Ray Fluorescenceの略称。物質にX線を照射したときに発生する蛍光X線を利用して、定性分析や定量分析を行う元素分析手法</li> </ul>
XRTmicron	<ul style="list-style-type: none"> <li>高輝度X線光源と専用光学系を用いた高分解能・高速X線トポグラフィ装置。Si、SiC、GaNなどの単結晶材料に対応。結晶欠陥を非破壊、全自動で検出できることから、半導体生産の歩留まり向上に寄与できる</li> </ul>
XtaLAB Synergy ED	<ul style="list-style-type: none"> <li>リガクの単結晶X線構造解析の要素技術と日本電子の透過型電子顕微鏡の要素技術を組み合わせて作られた電子線回折装置。従来よりも微細な粉末状の結晶でも測定が可能。これまで解析が困難であった物質でも構造情報を得ることができる</li> </ul>
ZSX Primus III NEXT	<ul style="list-style-type: none"> <li>定評のある上面照射型の走査型X線分析装置。生産管理で広く使われてきた汎用モデル「ZSX PrimusIII+」の後継機</li> </ul>
ZSX Primus IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>4kWの強力なX線を用いて、物質に含まれる元素を詳しく調べる波長分散型のX線分析装置</li> </ul>